

儀器設備介紹

設備名稱	原子層沉積系統(ALD system)
設備廠商/型號	高敦科技公司, KD-ALD
規 格	
RF 射頻電漿匹配器(100 W-400 W)、ALCATEL ATP-400 Turbo 幫浦、機械幫浦兩部、魯式幫浦一部。化學系相沉積系統控制系、4 英吋高溫基板加熱模組(75 °C-400 °C)。	
功 能	
以原子層沉積方式至被氧化鋅(ZnO)、氧化鋁鋅(AlZnO)、氧化鎂鋅(MgZnO)、氧化鋁(Al_2O_3)、氧化鎂(MgO)等薄膜。基板溫度可調變範圍為 75 °C-400 °C；本系統亦有遠端電漿源，可調控瓦數為(100 W-400 W)，其可用電漿氣體源為氫氣與氧氣。	
圖 片	
	